

	<p><b>SI4963BDY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4963BDY-T1-GE3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4963BDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8640 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4963BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8640 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6.5A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.9A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A
Basisteilenummer	SI4963

SI4963BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4963BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4963BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4963BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4963BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4963BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4963DY-T1-E3.</b> VISHAY SI4963DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI4963DY</b> SOP8 SI4963DY SOP8</p>
 <p><b>SI4963DY-T1</b> VISHAY SI4963DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4963BDY-T1-E3.</b> VISHAY SI4963BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI4963BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4963DY-T1-E3..</b> VISHAY SI4963DY-T1-E3.. VISHAY</p>

### SI4963BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4963BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4963BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4963BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4963BDY-T1-GE3 Electronic	SI4963BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4963BDY-T1-GE3-Bild	SI4963BDY-T1-GE3
SI4963BDY-T1-GE3 Preis	SI4963BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4963BDY-T1-GE3-Aktie	SI4963BDY-T1-GE3-Teil
SI4963BDY-T1-GE3 Neu	SI4963BDY-T1-GE3 Original	SI4963BDY-T1-GE3 RFQ	SI4963BDY-T1-GE3 Inventar
			SI4963BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited